均匀平面波的反射和透射[1]

电磁场与电磁波不挂科第六讲讲义

■ 矢量的加与减的几何意义

均匀平面波在传播过程中常会遇到不同媒质的分界面。

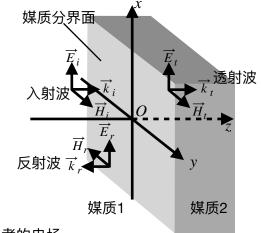
电磁波入射到某分界面上时,部分电磁能量被分界面反射形成反射波;

另一部分能量穿过分界面继续传播,形成透射波。

入射波的电场强度和磁场强度常用 E_i 和 H_i 表示;

反射波的电场和磁场用 E_r 和 H_r 表示;

透射波的电场和磁场用 E_t 和 H_t 表示。



反射波和透射波相较入射波,电磁能量发生改变,对应二者的电场

和磁场表达式中振幅的变化;

另外,反射波的传播方向与入射波相反,对应表示传播方向的相位因子的变化;

透射波的传播媒质发生变化,对应于媒质参数有关的物理量发生变化。

6.1.均匀平面波的垂直入射

6.1.1.对导电媒质分界面的垂直入射

■ 对导电媒质分界面的垂直入射

如右图所示,z < 0的半空间充满参数为 ε_1 、 μ_1 和 σ_1 的导电媒质1, z > 0的半空间充满参数为 ε_1 、 μ_2 和 σ_2 的导电媒质2,均匀平面波从媒质1垂直入射到z = 0的分界平面上。

媒质分界面 \overrightarrow{E}_{i} \overrightarrow{k}_{i} \overrightarrow{R}_{i} $\overrightarrow{$

假定入射波是沿x方向的线极化波。

■ 对导电媒质分界面的垂直入射「入射波」

媒质1中的入射波电场和磁场的表达式可写为:

$$\overrightarrow{E}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{x} E_{im} e^{-\gamma_{1} z}$$

$$\overrightarrow{H}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{z} \times \frac{1}{n_{1} c} \overrightarrow{E}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{1}{n_{1} c} E_{im} e^{-\gamma_{1} z}$$

其中:

$$\gamma_1 = jk_{1c} = j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_{1c}} = j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1(1-j\frac{\sigma_1}{\omega\varepsilon_1})}$$

$$\eta_{1c} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_{1c}}} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}} (1 - j \frac{\sigma_1}{\omega \varepsilon_1})^{-\frac{1}{2}}$$

■ 对导电媒质分界面的垂直入射「反射波」

部分电磁能量被分界面反射,形成反射波。相较入射波,反射波的传播方向发生变化,幅度 发生变化。

反射波的电场和磁场分别为:

$$\overrightarrow{E}_r(z) = \overrightarrow{e}_x E_{rm} e^{\gamma_1 z}$$

$$\overrightarrow{H}_r(z) = -\overrightarrow{e}_z \times \frac{1}{\eta_{1c}} \overrightarrow{E}_r(z) = -\overrightarrow{e}_y \frac{1}{\eta_{1c}} E_{rm} e^{\gamma_1 z}$$

媒质1中的电磁波由入射波和反射波合成, 合成波的电场和磁场为:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{E}_{1}(z) &= \overrightarrow{E}_{i}(z) + \overrightarrow{E}_{r}(z) = \overrightarrow{e}_{x}(E_{im}e^{-\gamma_{1}z} + E_{rm}e^{\gamma_{1}z}) \\ \overrightarrow{H}_{1}(z) &= \overrightarrow{H}_{i}(z) + \overrightarrow{H}_{r}(z) = \overrightarrow{e}_{y}\frac{1}{\eta_{1c}}(E_{im}e^{-\gamma_{1}z} - E_{rm}e^{\gamma_{1}z}) \end{aligned}$$

■ 对导电媒质分界面的垂直入射「透射波」

部分电磁能量穿过分界面继续传播,形成透射波。相较入射波,透射波的传播方向不变,幅 度和传播媒质发生变化。

其电场和磁场的表达式分别为:

$$\overrightarrow{E}_{t}(z) = \overrightarrow{e}_{x} E_{tm} e^{-\gamma_{2} z}$$

$$\overrightarrow{H}_{t}(z) = \overrightarrow{e}_{z} \times \frac{1}{\eta_{2c}} \overrightarrow{E}_{t}(z) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{1}{\eta_{2c}} E_{tm} e^{-\gamma_{2} z}$$

其中:

$$\gamma_2 = j\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_{2c}} = j\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2(1-j\frac{\sigma_2}{\omega\varepsilon_2})}$$

$$\eta_{2c} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_{2c}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} (1 - j \frac{\sigma_2}{\omega \varepsilon_2})^{-\frac{1}{2}}$$

媒质2中只有透射波,即 $E_2(z) = E_t(z)$, $H_2(z) = H_t(z)$ 。

■ 反射系数和透射系数

定义分界面上的反射系数 Γ 为反射波电场振幅 E_{rm} 与入射波电场振幅 E_{im} 的比值,其表达式

为:
$$\Gamma = \frac{E_{rm}}{E_{im}} = \frac{\eta_{2c} - \eta_{1c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}}$$
。

另定义分界面上的透射系数au为透射波电场振幅 E_{tm} 与入射波电场振幅 E_{im} 的比值,其表达式

为:
$$\tau = \frac{E_{tm}}{E_{im}} = \frac{2\eta_{2c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}}$$
。

「对于一般媒质的分界面, 电场强度和磁场强度满足的边界条件分别为:

$$\overrightarrow{e}_n \times (\overrightarrow{E}_1 - \overrightarrow{E}_2) = 0, \ \overrightarrow{e}_n \times (\overrightarrow{H}_1 - \overrightarrow{H}_2) = \overrightarrow{J}_s = 0.$$

将前面求出的 $E_1(z)$, $E_2(z)$, $H_1(z)$, $H_2(z)$ 代入边界条件(此时分界面的法线方向单位矢量 \overrightarrow{e}_n

为一
$$\overrightarrow{e}_z$$
),可以得到:
$$\begin{cases} E_{im} + E_{rm} = E_{tm} \\ \frac{E_{im}}{\eta_{1c}} - \frac{E_{rm}}{\eta_{1c}} = \frac{E_{tm}}{\eta_{2c}} \end{cases}$$

由此可解得:
$$E_{rm} = \frac{\eta_{2c} - \eta_{1c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}} E_{im}$$
, $E_{tm} = \frac{2\eta_{2c}}{\eta_{2c} + \eta_{1c}} E_{im}$. 」

由反射系数和透射系数的表达式可得二者关系为: $1 + \Gamma = \tau$ 。

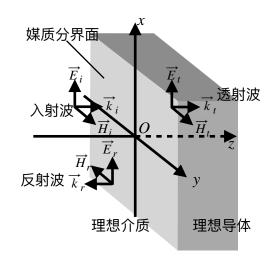
6.1.2.对理想导体平面的垂直入射

■ 对理想导体平面的垂直入射

如右图所示,x方向线极化的均匀平面波沿+z方向从理想介质垂直入射到理想导体,分界面为xy平面。

由于理想导体的电导率 $\sigma_2=\infty$,其本征阻抗为

$$\eta_{2c} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_{2c}}} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2 - j\frac{\sigma_2}{\varepsilon}}} \to 0;$$



将其代入透射和反射系数的表达式,得到 $\Gamma = -1$, $\tau = 0$,这表示理想导体将电磁波全部反射,导体内部的电磁场为零,没有电磁波产生透射。

■ 对理想导体平面的垂直入射「入射波」

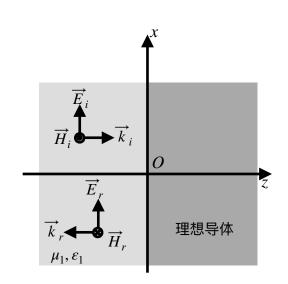
假定入射波是沿x方向的线极化波。

因为媒质1为理想介质,有 $\gamma_1=j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}=jeta_1$,

$$\eta_{1c} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}} = \eta_{1\circ}$$

则入射波电场和磁场的表达式可写为:

$$\begin{split} \overrightarrow{E}_{i}(z) &= \overrightarrow{e}_{x} E_{im} e^{-j\beta_{1}z} \\ \overrightarrow{H}_{i}(z) &= \overrightarrow{e}_{z} \times \frac{1}{\eta_{1}} \overrightarrow{E}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{1}{\eta_{1}} E_{im} e^{-j\beta_{1}z} \end{split}$$



■ 对理想导体平面的垂直入射「反射波」

设反射波的电场表达式为 $\overrightarrow{E}_r(z) = \overrightarrow{e}_x E_{rm} e^{j\beta_1 z}$,对理想导体分界面,有边界条件 $\overrightarrow{e}_n \times \overrightarrow{E}_{1|z=0} = -\overrightarrow{e}_z \times (\overrightarrow{E}_i + \overrightarrow{E}_r)_{|z=0} = -\overrightarrow{e}_y (E_{im+} E_{rm}) = 0$ 。

电磁能量被理想导体面全部反射,在分界面上应用理想导体的边界条件,可以得到反射波振幅 $E_{rm}=-E_{im}$;

则反射波的电场和磁场表达式为:

$$\overrightarrow{E}_r(z) = -\overrightarrow{e}_x E_{im} e^{j\beta_1 z}$$

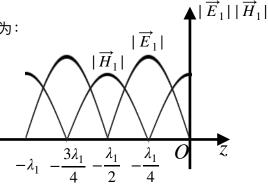
$$\overrightarrow{H}_r(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_{im} e^{j\beta_1 z}$$

■ 对理想导体平面的垂直入射「媒质1中的合成波」

媒质1中的电磁波由入射波和反射波合成,合成波的电磁场为:

$$\overrightarrow{E}_{1}(z) = \overrightarrow{e}_{x} E_{im} (e^{-j\beta_{1}z} - e^{j\beta_{1}z}) = -\overrightarrow{e}_{x} j 2E_{im} \sin \beta_{1}z$$

$$\overrightarrow{H}_{1}(z) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{1}{\eta_{1}} E_{im} (e^{-j\beta_{1}z} + e^{j\beta_{1}z}) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{2}{\eta_{1}} E_{im} \cos \beta_{1}z$$



其对应的瞬时表达式为:

$$\overrightarrow{E}_{1}(z,t) = Re[\overrightarrow{E}_{1}(z)e^{j\omega t}] = \overrightarrow{e}_{x}2E_{im}\sin\beta_{1}z\sin\omega t$$

$$\overrightarrow{H}_{1}(z,t) = Re[\overrightarrow{H}_{1}(z)e^{j\omega t}] = \overrightarrow{e}_{y}\frac{2}{n_{1}}E_{im}\cos\beta_{1}z\cos\omega t$$

由此可知, 合成波的相位仅与时间有关, 即空间中各点的相位相同;

各点处的电场和磁场强度的振幅表达式分别为:

$$|\overrightarrow{E}_{1}(z)| = 2E_{im}|\sin \beta_{1}z|$$

$$|\overrightarrow{H}_{1}(z)| = \frac{2}{\eta_{1}}E_{im}|\cos \beta_{1}z|$$

对电场来说,当 $\beta_1 z = -n\pi$,即 $z = -\frac{n\lambda_1}{2}$ (n = 0,1,2,3,...)时,电场振幅始终为零,称这些点为波节点。

当
$$\beta_1 z = -(n+\frac{1}{2})\pi$$
,即 $z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$ $(n=0,1,2,3,...)$ 时,电场振幅达到最大值,

称这些点为波腹点。

合成波的波腹和波节位置始终不变。

各点处的电场强度瞬时值随时间变化,但波形不向前推进,即合成波在空间没有移动,只是 在原来的位置振动,称这种波为驻波。

同样地,可以看出磁场也为驻波。

当
$$\beta_1 z = -n\pi$$
时产生波腹,当 $\beta_1 z = -\frac{(2n+1)\pi}{2}$ 时产生波节。

电场和磁场有 $\frac{\pi}{2}$ 的空间相位差,位置上错开 $\frac{\lambda_1}{4}$ 。在理想导体表面上(z=0处),合成波电

场有最小振幅点,
$$|\vec{E}_1(0)|$$
为零;磁场有最大振幅点, $|\vec{H}_1(0)| = \frac{2}{\eta_1}E_{im}$ 。

合成波的平均坡印廷矢量为

$$\overrightarrow{S}_{1av} = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{E}_1(z) \times \overrightarrow{H}_1^*(z)] = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{e}_z j \frac{4 \overrightarrow{E}_{im}^2}{\eta_1} \sin \beta_1 z] = 0$$

表示驻波不发生电磁能量的传输,仅在两个波节间进行电场能量和磁场能量的交换。

合成波电场和磁场的瞬时表达式为

$$\overrightarrow{E}_{1}(z,t) = Re[\overrightarrow{E}_{1}(z)e^{j\omega t}] = \overrightarrow{e}_{x}2E_{im}\sin\beta_{1}z\sin\omega t$$

$$\overrightarrow{H}_{1}(z,t) = Re[\overrightarrow{H}_{1}(z)e^{j\omega t}] = \overrightarrow{e}_{y}\frac{2}{\eta_{1}}E_{im}\cos\beta_{1}z\cos\omega t$$

■ 例题6-1

一右旋圆极化波垂直入射至位于z=0的理想导体板上,其电场强度的复数形式为

$$\overrightarrow{E}_{i}(z) = (\overrightarrow{e}_{x} - \overrightarrow{e}_{y}j)E_{m}e^{-j\beta z}$$

- (1) 确定反射波的极化;
- (2) 写出总电场强度的瞬时表达式;
- (3) 求板上的感应面电流密度。

■ 例题6-2

有一频率为 $100MH_Z$ 、沿y方向极化的均匀平面波从空气(x < 0区域)中垂直入射到位于 x = 0的理想导体板上。设入射波电场 \overrightarrow{E}_i 的振幅为10~V/m。

- (1) 入射波电场 \overrightarrow{E}_i 的磁场 \overrightarrow{H}_i 的复矢量;
- (2) 反射波电场 \overrightarrow{E} ,的磁场 \overrightarrow{H} ,的复矢量;
- (3) 合成波电场 \overrightarrow{E}_1 的磁场 \overrightarrow{H}_1 的复矢量;
- (4) 距离导体平面最近的合成波电场 \overrightarrow{E}_1 为0的位置;
- (5) 距离导体平面最近的合成波磁场 \overrightarrow{H}_1 为0的位置;

■ 例题6-3

一均匀平面波沿+2方向传播,其电场强度矢量为

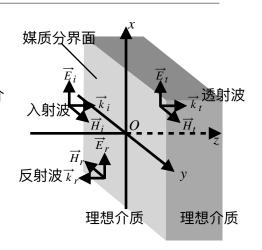
$$\overrightarrow{E} = \overrightarrow{e}_x 100 \sin(\omega t - \beta z) + \overrightarrow{e}_y 200 \cos(\omega t - \beta z) V/m_o$$

- (1) 应用麦克斯韦方程求相伴的磁场 \overrightarrow{H} ;
- (2)若在波传播方向上z=0处,放置一无限大的理想导体板,求z<0区域中的 \overrightarrow{E}_1 和 \overrightarrow{H}_1 ;
 - (3) 求理想导体板表面的电流密度。

6.1.3.对理想介质分界面的垂直入射

■ 对理想介质分界面的垂直入射

如右图所示,x方向线极化的均匀平面波沿+z方向从理想介质垂直入射到另一理想介质,分界面为xy平面。



由于理想介质的电导率 $\sigma_1 = \sigma_2 = 0$,则有

$$\gamma_1 = j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1} = j\beta_1, \ \eta_{1c} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}} = \eta_1;$$

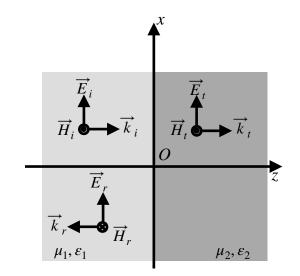
$$\gamma_2 = j\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2} = j\beta_2, \ \eta_{2c} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}} = \eta_2.$$

将其代入透射和反射系数的表达式,得到

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

此时 η_1, η_2 都是实数。



■ 对理想介质分界面的垂直入射「入射波」

假定入射波是沿x方向的线极化波。

因为媒质1为理想介质,有
$$\gamma_1=j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}=j\beta_1$$
, $\eta_{1c}=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}=\eta_1$ 。

则入射波电场和磁场的表达式可写为

$$\overrightarrow{E}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{x} E_{im} e^{-j\beta_{1}z}, \quad \overrightarrow{H}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{z} \times \frac{1}{\eta_{1}} \overrightarrow{E}_{i}(z) = \overrightarrow{e}_{y} \frac{1}{\eta_{1}} E_{im} e^{-j\beta_{1}z}.$$

■ 对理想介质分界面的垂直入射「反射波」

电磁能量被理想介质分界面部分反射,反射波的振幅可表示为 $E_{rm}=\Gamma E_{im}$;则反射波的电场和磁场表达式为 $\overrightarrow{E}_r(z)=\overrightarrow{e}_x\Gamma E_{im}e^{j\beta_1z},\ \overrightarrow{H}_r(z)=-\overrightarrow{e}_y\frac{1}{n_1}\Gamma E_{im}e^{j\beta_1z}$ 。

由反射系数的表达式可知,当 $\eta_2 > \eta_1$ 时反射系数 $\Gamma > 0$,此时分界面上反射波和入射波的电场同相位;当 $\eta_2 < \eta_1$ 时 $\Gamma < 0$,两电场符号相反,因为 $-1 = e^{j\pi}$,所以分界面上二者相位相差 π 。

媒质1中的电磁波由入射波和反射波合成,合成波的电磁场为:

$$\overrightarrow{E}_1 = \overrightarrow{e}_x E_{im} (e^{-j\beta_1 z} + \Gamma e^{j\beta_1 z}), \quad \overrightarrow{H}_1 = \overrightarrow{e}_y \frac{E_{im}}{\eta_1} (e^{-j\beta_1 z} - \Gamma e^{j\beta_1 z}).$$

■ 对理想介质分界面的垂直入射「透射波」

部分电磁能量穿过分界面继续传播形成透射波,其振幅可表示为 $E_{tm}=\tau E_{im}$,其电场和磁场的表达式分别为: $\overrightarrow{E}_t(z)=\overrightarrow{e}_x \tau E_{im} e^{-j\beta_2 z}$, $\overrightarrow{H}_t(z)=\overrightarrow{e}_y \frac{\tau}{\eta_2} E_{im} e^{-j\beta_2 z}$ 。

媒质2中只有透射波,即 $E_2(z) = E_t(z)$, $H_2(z) = H_t(z)$ 。

■ 对理想介质分界面的垂直入射「媒质1中的合成波」

媒质1中合成波的电场复数表达式为 $\overrightarrow{E}_1=\overrightarrow{e}_x E_{im}(e^{-j\beta_1 z}+\Gamma e^{j\beta_1 z})$; 为方便理解其性质,根据 $e^{j\beta_1 z}-e^{-j\beta_1 z}=j2\sin\beta_1 z$ 对上式进行变换,得:

$$\overrightarrow{E}_1 = \overrightarrow{e}_x E_{im} (e^{-j\beta_1 z} + \Gamma e^{j\beta_1 z} + \Gamma e^{-j\beta_1 z} - \Gamma e^{-j\beta_1 z}) = \overrightarrow{e}_x E_{im} [(1 + \Gamma) e^{-j\beta_1 z} + j2\Gamma \sin \beta_1 z]$$

同理可得合成波的磁场复数表达式:

$$\overrightarrow{H}_1 = \overrightarrow{e}_y \frac{E_{im}}{\eta_1} (e^{-j\beta_1 z} - \Gamma e^{j\beta_1 z}) = \overrightarrow{e}_y \frac{E_{im}}{\eta_1} [(1 + \Gamma)e^{-j\beta_1 z} - 2\Gamma \cos \beta_1 z]$$

观察电场表达式,由于 $\overrightarrow{e}_x j 2\Gamma E_{im} \sin \beta_1 z$ 满足驻波形式,而 $e^{-j\beta_1 z} = \cos \beta_1 z - j \sin \beta_1 z$ 部分没有固定的波节波腹,故可将合成波电场分为行波和驻波两部分:行波对应传播因子为 $e^{-j\beta_1 z}$ 的 $\overrightarrow{e}_x E_{im} (1+\Gamma) e^{-j\beta_1 z}$ 部分;驻波为 $\overrightarrow{e}_x j 2\Gamma E_{im} \sin \beta_1 z$ 部分。

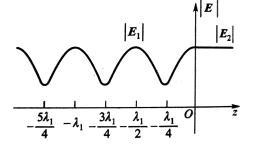
媒质1中合成波的电场复数表达式为 $\overrightarrow{E}_1=\overrightarrow{e}_x E_{im}[(1+\Gamma)e^{-j\beta_1z}+j2\Gamma\sin\beta_1z]$,其振幅为 $|\overrightarrow{E}_1(z)|=E_{im}\sqrt{1+\Gamma^2+2\Gamma\cos(2\beta_1z)}\,.$

当
$$\Gamma > 0$$
时,在 $z = -\frac{n\lambda_1}{2}$ $(n = 0,1,2,3,...)$ 时合成波电场振幅取得最大值

$$|\overrightarrow{E}_{1}(z)|_{max} = E_{im}(1+\Gamma);$$

在
$$z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$$
 $(n=0,1,2,3,...)$ 时振幅取得最小值 $|\overrightarrow{E}_1(z)|_{min} = E_{im}(1-\Gamma)$ 。

此时电场振幅波形如右图所示,在分界面上有振幅最大点。

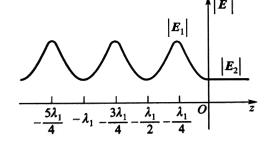


当 $\Gamma < 0$ 时,在 $z = -\frac{(2n+1)\lambda_1}{4}$ (n = 0,1,2,3,...)时合成波电场振幅取得最大值

$$|\overrightarrow{E}_{1}(z)|_{max} = E_{im}(1 - \Gamma);$$

在
$$z = -\frac{n\lambda_1}{2}$$
 $(n = 0,1,2,3,...)$ 时振幅取得最小值 $|\overrightarrow{E}_1(z)|_{min} = E_{im}(1+\Gamma)$ 。

此时电场振幅波形如右图所示,在分界面上有振幅最小点。



媒质1中合成波的电场复数表达式为 $\overrightarrow{E}_1=\overrightarrow{e}_x E_{im}[(1+\Gamma)e^{-jeta_1z}+j2\Gamma\sineta_1z]$,其振幅为 $|\overrightarrow{E}_1(z)|=E_{im}\sqrt{1+\Gamma^2+2\Gamma\cos(2eta_1z)}\,.$

同样的, 合成波磁场的振幅也能由其复数表达式推得:

$$|\overrightarrow{H}_1(z)| = \frac{E_{im}}{\eta_1} |\sqrt{1 + \Gamma^2 - 2\Gamma \cos(2\beta_1 z)}.$$

可以看出电场和磁场振幅的最大值和最小值的出现位置正好互换。

■ 驻波系数

定义驻波系数(驻波比)S为合成波电场强度最大值和最小值之比,即

由驻波系数表达式可得: $|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1}$ 。

■ 两种媒质中电磁波的平均功率密度

入射波的平均功率密度为:

$$\overrightarrow{S}_{iav} = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{e}_x E_i \times \overrightarrow{e}_y H_i^*] = \overrightarrow{e}_z \frac{E_{im}^2}{2\eta_1}$$

反射波的平均功率密度为:

$$\overrightarrow{S}_{rav} = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{e}_x E_r \times \overrightarrow{e}_y H_r^*] = -\overrightarrow{e}_z \frac{E_{im}^2}{2\eta_1} \Gamma^2$$

媒质1中合成波沿z方向传播的平均功率密度为:

$$\overrightarrow{S}_{1av} = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{e}_x E_1 \times \overrightarrow{e}_y H_1^*] = \overrightarrow{e}_z \frac{E_{im}^2}{2\eta_1} (1 - \Gamma^2)$$

媒质2中透射波的平均功率密度为:

$$\overrightarrow{S}_{2av} = \frac{1}{2} Re[\overrightarrow{e}_x E_2 \times \overrightarrow{e}_y H_2^*] = \overrightarrow{e}_z \frac{E_{im}^2}{2\eta_2} \tau^2$$

利用
$$1 + \Gamma = \tau$$
和 $\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$,容易证明 $\overrightarrow{S}_{1av} = \overrightarrow{S}_{2av}$ 。

■ 例题6-4

一均匀平面波自空气中垂直入射到半无限大的无耗介质表面上,已知空气中合成波的驻波比为3,介质内透射波的波长是空气中波长的1/6,且介质表面上为合成波电场的最小点。求介质的相对磁导率 μ_r 和相对介电常数 ϵ_r 。

■ 例题6-5

一圆极化波自空气中垂直入射于一介质板上,介质板的本征阻抗为 η_2 。入射波电场为 $\overrightarrow{E}=E_m(\overrightarrow{e_x}+\overrightarrow{e_y}j)e^{-j\beta z}$ 。

求反射波与透射波的电场,它们的极化情况如何?

■ 例题6-6

入射波电场 $\overrightarrow{E_i} = \overrightarrow{e_x} 10 \cos(3\pi \times 10^9 t - 10\pi z) \ V/m$,从空气(z < 0区域)中垂直入射到 z = 0的分界面上,在z > 0区域中 $\mu_r = 1$ 、 $\varepsilon_r = 4$ 、 $\sigma = 0$ 。 求z > 0区域的电场 $\overrightarrow{E_2}$ 和磁场 $\overrightarrow{H_2}$ 。

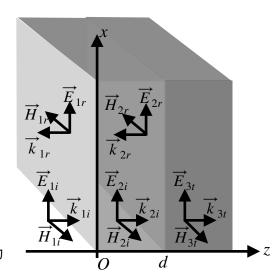
6.1.4.对多层介质分界面的垂直入射

■ 对三层介质分界平面的垂直入射

考虑三层不同的无损耗介质产生的两个分界面,介质1和介质2产生的分界面位于z=0;介质2厚度为d,并在z=d处与介质3交界。

电磁波从介质1垂直入射,首先在分界面z = 0处产生反射和透射;透射波在介质2中传播,垂直入射分界面 z = d,再次产生反射和透射。

两个分界面的反射系数分别设为 Γ_1,Γ_2 ,透射系数分别设为 au_1, au_2 。



■ 对三层介质分界平面的垂直入射「无损媒质1中的电磁波」

设媒质1中的入射波为
$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_{1i}(z) = \overrightarrow{e}_x E_{1im} e^{-j\beta_1 z} \\ \overrightarrow{H}_{1i}(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_{1im} e^{-j\beta_1 z} \end{cases}$$

则反射波为
$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_{1r}(z) = \overrightarrow{e}_x E_{1rm} e^{j\beta_1 z} = \overrightarrow{e}_x \Gamma_1 E_{1im} e^{j\beta_1 z} \\ \overrightarrow{H}_{1r}(z) = -\overrightarrow{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_{1rm} e^{j\beta_1 z} = -\overrightarrow{e}_y \frac{1}{\eta_1} \Gamma_1 E_{1im} e^{j\beta_1 z} \end{cases}$$

媒质1中的合成波为二者之和
$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_1(z) = \overrightarrow{e}_x E_{1im}(e^{-j\beta_1 z} + \Gamma_1 e^{j\beta_1 z}) \\ \overrightarrow{H}_1(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{E_{1im}}{\eta_1}(e^{-j\beta_1 z} - \Gamma_1 e^{j\beta_1 z}) \end{cases}$$

■ 对三层介质分界平面的垂直入射「无损媒质2中的电磁波」

经分界面z = 0的透射波为分界面z = d的入射波,故可将其电场表示为:

$$\overrightarrow{E}_{2i}(z) = \overrightarrow{e}_x E_{2im} e^{-j\beta_2(z-d)} = \overrightarrow{e}_x \tau_1 E_{1im} e^{-j\beta_2(z-d)}.$$

其磁场为:
$$\overrightarrow{H}_{2i}(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{\tau_1 E_{1im}}{n_2} e^{-j\beta_2(z-d)}$$
。

分界面
$$z=d$$
处的反射波为:
$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_{2r}(z) = \overrightarrow{e}_x \tau_1 \Gamma_2 E_{1im} e^{j\beta_2(z-d)} \\ \overrightarrow{H}_{2r}(z) = -\overrightarrow{e}_y \frac{\tau_1 \Gamma_2 E_{1im}}{\eta_2} e^{j\beta_2(z-d)} \end{cases}$$

媒质2中的合成波为:

$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_2(z) = \overrightarrow{e}_x E_{2im} [e^{-j\beta_2(z-d)} + \Gamma_2 e^{j\beta_2(z-d)}] = \overrightarrow{e}_x \tau_1 E_{1im} [e^{-j\beta_2(z-d)} + \Gamma_2 e^{j\beta_2(z-d)}] \\ \overrightarrow{H}_2(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{\tau_1 E_{1im}}{\eta_2} [e^{-j\beta_2(z-d)} - \Gamma_2 e^{j\beta_2(z-d)}] \end{cases}$$

■ 对三层介质分界平面的垂直入射「无损媒质3中的电磁波」

媒质3中只存在透射波,可写为:
$$\begin{cases} \overrightarrow{E}_3(z) = \overrightarrow{e}_x E_{3im} e^{-j\beta_3(z-d)} = \overrightarrow{e}_x \tau_1 \tau_2 E_{1im} e^{-j\beta_3(z-d)} \\ \overrightarrow{H}_3(z) = \overrightarrow{e}_y \frac{\tau_1 \tau_2 E_{1im}}{\eta_3} e^{-j\beta_3(z-d)} \end{cases}$$

■ 透射系数和反射系数「z=d处」

分界面z = d处的情况与前面单一分界面时类似:从图中看,该分界面左侧为入射波和反射波,右侧只有透射波。

故对该分界面应用边界条件,得到相应的透射系数和反射系数:

$$\Gamma_2 = \frac{\eta_3 - \eta_2}{\eta_3 + \eta_2}$$

$$\tau_2 = 1 + \Gamma_2 = \frac{2\eta_3}{\eta_3 + \eta_2}$$

■ 透射系数和反射系数「z=0处」

分界面z = 0处的情况与前面单一分界面时有较大差别: 从图中看,该分界面左侧为入射波和反射波,右侧不仅有透射波还有分界面z = d反射的反射波。故对该分界面应用边界条件,得到的透射系数和反射系数相较前面的复杂:

$$\Gamma_1 = \frac{\eta_{ef} - \eta_1}{\eta_{ef} + \eta_1}$$

$$\tau_1 = \frac{1 + \Gamma_1}{e^{j\beta_2 d} + \Gamma_2 e^{-j\beta_2 d}}$$

其中 $\eta_{ef} = \frac{E_2(0)}{H_2(0)}$,称为z = 0处的等效波阻抗,它的另一表达式为:

$$\eta_{ef} = \eta_2 \frac{\eta_3 + j\eta_2 \tan(\beta_2 d)}{\eta_2 + j\eta_3 \tan(\beta_2 d)}.$$

■ 对多层介质分界平面的垂直入射

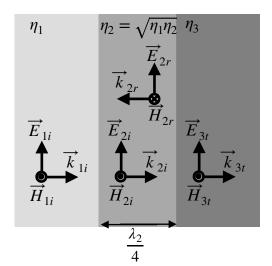
对n(>3)层媒质的垂直入射情况,依然先计算最后一个分界面的反射系数 Γ_{n-1} ,然后求出前一个分界面处的等效波阻抗和反射系数 Γ_{n-2} ,依次类推直至求得第一个分界面处的等效波阻抗和反射系数。

■ 四分之一波长匹配层

在两种不同的媒质之间插入一层媒质,其厚度为该媒质对应波长的四分之一,即 $d=rac{\lambda_2}{4}$ 。

如右图所示,插入的媒质与另外两种媒质构成三层介质的分界平面,则有 $\eta_{ef}=\eta_2\frac{\eta_3+j\eta_2\tan(\beta_2d)}{\eta_2+j\eta_3\tan(\beta_2d)},$

$$\Gamma_1 = \frac{\eta_{ef} - \eta_1}{\eta_{ef} + \eta_1}.$$



$$d=rac{\lambda_2}{4}$$
时,有 $\beta_2 d=rac{2\pi}{\lambda_2}rac{\lambda_2}{4}=rac{\pi}{2}$,即 $an(eta_2 d)= anrac{\pi}{2} o\infty$ 。

故等效波阻抗化为 $\eta_{ef}=rac{\eta_2^2}{\eta_3}$ 。

当媒质2的本征阻抗为 $\eta_2=\sqrt{\eta_1\eta_3}$ 时,有 $\eta_{ef}=\eta_1$,此时 $d=\frac{\lambda_2}{4}$,媒质1与2的分界面上的反射系数为 $\Gamma_1=0$ 。

这表明,若在媒质1和媒质3之间插入一层厚度为 $\frac{\lambda_2}{4}$ 的媒质作为媒质2,只要媒质2的波阻抗满足 $\eta_2=\sqrt{\eta_1\eta_3}$,就能消除媒质1与媒质2分界面上的反射。称媒质2为四分之一波长匹配层。

■ 例题6-7

频率 $100GH_Z$ 的均匀平面波从空气中垂直入射到 $\varepsilon=4\varepsilon_0$ 、 $\mu=\mu_0$ 、 $\sigma=0$ 的理想媒质平面上,为了消除反射,在媒质表面涂上1/4波长的匹配层。 试求匹配层的相对介电常数和最小厚度。

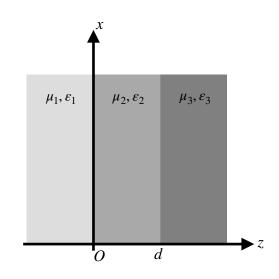
■ 半波长介质窗

对右图所示的三层媒质,有

$$\eta_{ef} = \eta_2 \frac{\eta_3 + j\eta_2 \tan(\beta_2 d)}{\eta_2 + j\eta_3 \tan(\beta_2 d)}$$

$$\Gamma_1 = \frac{\eta_{ef} - \eta_1}{\eta_{ef} + \eta_1}$$

$$\tau_1 = \frac{1 + \Gamma_1}{e^{j\beta_2 d} + \Gamma_2 e^{-j\beta_2 d}}$$



若媒质1和媒质3是相同的媒质,即 $\eta_1 = \eta_3$ 。

当媒质2的厚度
$$d=rac{\lambda_2}{2}$$
时,有 $eta_2 d=rac{2\pi}{\lambda_2}rac{\lambda_2}{2}=\pi$,即 $an(eta_2 d)= an\pi=0$ 。

故等效波阻抗可化为 $\eta_{ef} = \eta_3 = \eta_1$ 。

此时媒质1和2的分界面的反射和透射系数分别为:

$$\Gamma_1 = 0$$

$$\tau_1 = -\frac{1}{1 + \Gamma_2}$$

又因 $au_2=1+\Gamma_2$,故 $au_1 au_2=-1$,则有 $E_{3tm}= au_1 au_2E_{1im}=-E_{1im}$,这表明,在媒质1和3之间插入一厚度 $d=rac{\lambda_2}{2}$ 的媒质作为媒质2,则电磁波能无损耗地传入媒质3。称厚度为二分之一波长的媒质2为半波长介质窗。

微信扫描二维码获取更多课程



